# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-325913

(43)公開日 平成6年(1994)11月25日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H 0 1 C	17/00	Z	8834-5E		
	1/032				
	1/04				
	7/00	В			

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 4 頁)

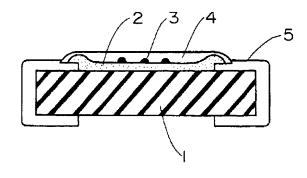
(21)出顯番号	特顯平5-136482	(71)出願人	000116024
(22)出願日	平成5年(1993)5月14日	(72)発明者	ローム株式会社 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地 玉木 善
		<b>C</b> =2,7 <b>C</b> ,7, <b>L</b>	京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株 式会社内

## (54)【発明の名称】 チップ抵抗器の製造方法

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 チップ抵抗器における微細な標印を可能と し、しかも標印のかすれ、消失等の生じない技術を提供 することを目的とする。

【構成】 チップ抵抗器の標印3をフォトリソグラフィ 法により行い、該標印を透明乃至半透明の樹脂保護層4 で覆った。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 抵抗体層が形成された絶縁性基板上に感 光性樹脂を塗布し、所定の標印パターンが形成されたマ スクにより上記感光性樹脂を露光処理し、現像して標印 パターンを形成し、上記抵抗体層及び標印パターンを覆 うように透明乃至半透明の樹脂保護層を設けることを特 徴とするチップ抵抗器の製造方法。

【請求項2】 絶縁性基板上に抵抗体層を形成する工程 と、抵抗体層をトリミングして抵抗値を調整する工程 と、上記抵抗体層を含む上記絶縁性基板上に感光性樹脂 10 を塗布する工程と、所定のパターンが形成されたマスク により上記感光性樹脂を露光処理し現像して上記トリミ ングにより形成されるトリミング溝を覆う保護パターン と標印パターンとを形成する工程と、上記抵抗体層、保 護パターン及び標印パターンを覆うように透明乃至半透 明の樹脂保護層を設ける工程とを含むことを特徴とする チップ抵抗器の製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、チップ抵抗器の製造方 法に関し、より詳しくはチップ状の薄膜抵抗器及び厚膜 抵抗器の製造方法に関する。

### [0002]

【従来の技術】一般にチップ抵抗器 (薄膜抵抗器及び厚 膜抵抗器)の表面には、抵抗値識別等のための文字、マ ーク等の標印が施されている。従来より上記標印は、絶 縁性基板上に設けられた抵抗体層を覆うガラスの保護層 上に、スクリーン印刷等の印刷、転写等によって設けら れている。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、最近ま すます進む電子部品の小型化につれて上記チップ抵抗器 も小型化されてきており、従来の標印形成方法である印 刷、転写等では対応しきれなくなってきている。

【0004】例えば、形状寸法が1.6×0.8mmの チップ抵抗器では、実際の標印箇所は1.0×0.6m m程度以下となり、幅50μm程度以上の細線では表記 が不明確となる。しかしながら、上記印刷又は転写は、 微細な標印には不適合で、幅50μm程度以下の細線を 形成しようとするとぼやけ又はかすれが生じてしまうの 40 である。

【0005】また、上記標印は、保護層の表面に設けら れているために、標印面が露出状態となる。よって、標 印が上記のような細線による微細なものでは、製造工程 における標印後の工程、例えばチップ抵抗器の製造工程 で通常行われるブレーキング工程、メッキ工程等或いは 搬送時等において、各種製造機器、ケース等との接触又 は擦れ、或いは部品同士による擦れによって、標印がか すれたり消失したりするのである。

ップ抵抗器表面には標印部の凹凸が生じることとなる。 チップ抵抗器の寸法が小さくなると上記凹凸が実装時の 吸着コレットの吸着力を低下させ、実装不良の原因とな

【0007】本発明は、上記問題を解消し、微細な標印 でもシャープな表記を可能とし、標印のかすれ、消失等 が生じることのないチップ抵抗器の製造方法を提供する ことを目的とする。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記技術の 現状に鑑み鋭意研究を重ねた結果、チップ抵抗器におけ る標印をフォトリソグラフィ法により行い、該標印を透 明乃至半透明の樹脂保護層で覆うときは、標印のパター ンがシャープで読み取れ易く、標印のかすれ、消失等が 生じることなく、しかもチップ抵抗器の表面を平滑にで きることを見出した。

【0009】即ち、本発明は、以下のチップ抵抗器の製 造方法に係るものである。

【0010】(1)抵抗体層が形成された絶縁性基板上 に感光性樹脂を塗布し、所定の標印パターンが形成され たマスクにより上記感光性樹脂を露光処理し、現像して 標印パターンを形成し、上記抵抗体層及び標印パターン を覆うように透明乃至半透明の樹脂保護層を設けること を特徴とするチップ抵抗器の製造方法。

【0011】(2)絶縁性基板上に抵抗体層を形成する 工程と、抵抗体層をトリミングして抵抗値を調整する工 程と、上記抵抗体層を含む上記絶縁性基板上に感光性樹 脂を塗布する工程と、所定のパターンが形成されたマス クにより上記感光性樹脂を露光処理し現像して上記トリ 30 ミングにより形成されるトリミング溝を覆う保護パター

ンと標印パターンとを形成する工程と、上記抵抗体層、 保護パターン及び標印パターンを覆うように透明乃至半 透明の樹脂保護層を設ける工程とを含むことを特徴とす るチップ抵抗器の製造方法。

### [0012]

【作用】フォトリソグラフィ法により標印を行うので、 1 μmオーダーの幅の細線であってもぼやけのない明確 な表記が可能となる。

【0013】感光性樹脂を低粘度に調整することで、標 印形成と同時にトリミング溝を確実に埋めることができ

【0014】透明乃至半透明の樹脂保護層を設けるので 標印のかすれ又は消失が生じず、しかも表面を平滑にす ることができる。

#### [0015]

【実施例】以下、本発明の製造方法をチップ状の厚膜抵 抗器に適用した場合の実施例を、図面を参照しつつ説明 するが、本発明はこれら実施例に限定されることはな 11

【0006】更に、標印が最上層に設けられるめに、チ 50 【0016】図1乃至図3は、本発明の実施例を示す図

であり、図1は本発明の方法により得られる厚膜抵抗器 の断面図を示し、図2は本発明の方法を説明する平面図 である。これら図において、符号1は絶縁性基板を、2 は抵抗体層を、3は標印パターン層を、4は樹脂保護層 を、5は電極層を、6は感光性樹脂層を示す。

【0017】図1において、標印パターン層3は、抵抗 体層2上に設けられる。ここでは、上記標印パターン層 3は、抵抗体層2上に設けられているが、標印パターン 層3の一部乃至全部が絶縁性基板1上に掛かるように設 層2の露出部と共に透明乃至半透明の樹脂保護層4で覆 われている。

【0018】次に、本実施例を図2(a)~(d)に基 づきより具体的に説明する。

【0019】図2(a)に示すように、絶縁性基板1上 に抵抗体層2及び電極層5を設け、その後レーザ等によ り抵抗体層2をトリミングしてトリミング溝7を形成し つつ抵抗値が調整される。

【0020】図2(b)に示すように、感光性樹脂層6 を上記のようにして設けられた抵抗体層2上に膜厚1~20 明確に行うことができる。 10μm程度となるように設ける。感光性樹脂層6は、 例えば感光性樹脂をスピンコート、ロールコート等によ り塗布し、仮乾燥を行うことにより設けることができ る。上記感光性樹脂としては、公知のネガ型及びポジ型 のフォトレジストの他、光 (紫外線を含む)により上記 フォトレジストにおけるネガ型及びポジ型と同様の作用 を発現する樹脂類を限定されることなく広く使用でき、 より具体的には感光性ポリイミド樹脂等が例示できる。 また、上記感光性樹脂層6は、下地となる層とのコント ラストが高くなるように顔料等で着色されるのが好まし 30 ることができる。 11

【0021】次に、図2(c)に示すように、上記感光 性樹脂層6に所定の標印パターンの形成されたマスクを 用いて感光処理し、所定の現像液、例えばアルカリ系有 機溶剤等で現像処理して必要な部分 (標印パターン層 3)を残して感光性樹脂層6を除去する。上記感光処理 で標印パターン層3の硬化が不十分なときは、上記現像 処理後に再度光を照射して更に硬化を促進させてもよ 11

【 0 0 2 2 】本実施例では、トリミング溝7 Lの感光性 40 樹脂層6を除去したが、図3に示すようにトリミング溝 7を埋めるように感光性樹脂層6を残し、標印パターン 層3とともに保護パターン層3 aを形成してもよい。こ の時、感光性樹脂層6は低粘度に調整され塗布されるの が好ましく、このようにすることでトリミング溝7を隙 間なく覆うことができ、上記樹脂保護層4を設けたとき にトリミング溝7中の空気よりピンホールが生じたり、

トリミング溝7から外気に通じる隙間が生じたりするこ とがなくなり、より確実に水分浸入等による抵抗体層2 への悪影響を防止し得る。

【0023】また、図2(c)では、標印部の感光性樹 脂層6を残すように標印パターン層3を設けているが、 標印部のみを除去してその周囲の感光性樹脂層6を残す ようにしてもよい。

【0024】そして、図2(d)に示すように、標印パ ターン層3及び抵抗体層2の露出部を覆うようにスクリ けられてもかまわない。そして上記標印層3は、抵抗体 10 一ン印刷法、フォトリソ法等により透明又は標印パター ン層3の表示色とは異なる半透明の樹脂保護層4を設け

> 【0025】以上本発明の方法を厚膜抵抗器について説 明したが、本発明の方法は薄膜抵抗器の製造においても 適用できる。

[0026]

【発明の効果】本発明の製造方法は、以下のような効果 を奏するものである。

【0027】(1)小型のチップ部品であっても標印が

【0028】(2)標印にぼやけ、かすれ又は消失が生 じることがない。

【0029】(3)抵抗体層の保護と標印の保護とを同 一の保護層で行うことができる。

【0030】(4)チップ抵抗器の表面を平滑にするこ とができ、吸引コレットによる吸着性を改善し得るので 確実な実装を行うことができる。

【0031】(5)標印と同一工程でトリミング溝を確 実に埋めることができ、信頼性の高いチップ抵抗器を得

## 【図面の簡単な説明】

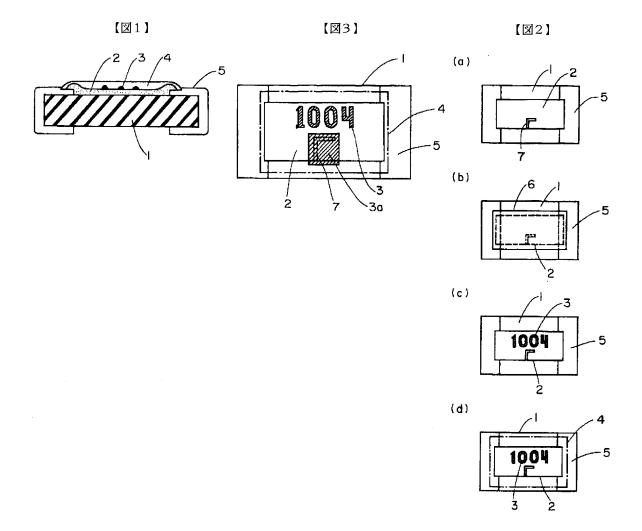
【図1】本発明の実施例により得られるチップ抵抗器の 断面図である。

【図2】本発明の実施例を説明するための工程図であ

【図3】本発明の他の実施例により得られるチップ抵抗 器の断面図である。

#### 【符号の説明】

	1	絶縁性基板
)	2	抵抗体層
	3	標印パターン層
	3 a	保護パターン層
	4	樹脂保護層
	5	電極層
	6	感光性樹脂層
	7	トリミング溝



PAT-NO:

JP406325913A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 06325913 A

TITLE:

MANUFACTURE OF CHIP RESISTOR

PUBN-DATE:

November 25, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TAMAKI, ZENICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

ROHM CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP05136482

APPL-DATE:

May 14, 1993

•

INT-CL (IPC): H01C017/00, H01C001/032 , H01C001/04 , H01C007/00

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent the generation of a blur, a disappearance or the like of a marking by a method wherein a chip resistor is marked by a photolithography method and this marking is covered with a transparent or semitransparent resin protective layer.

CONSTITUTION: A resistor layer 2 and an electrode layer 5 are provided on an insulative substrate 1 and after that, the layer 2 is trimmed by a laser or the like and while a trimming groove 7 is formed, the resistance value of the layer 2 is adjusted. Then, a photosensitive resin layer 6 is provided on the layer 2 in such a way that its film thickness is 1 to 10μ m or thereabouts. this layer 6 is exposed to light using a mask formed with a prescribed marking pattern, the layer 6 is developed with a prescribed developing solution to leave a marking pattern layer 3 and the layer 6 is removed. A transparent or semitransparent resin protective layer 4 is provided in such a way as to cover the layer 3 and the exposed part of the layer 2. Thereby, even a

microscopic
marking is made possible a sharp notation and a chip resistor, on which
a blur,
a disappearance or the like of the marking is never generated, can be
manufactured.

COPYRIGHT: (C) 1994, JPO